

Parameter: Werte:
Bearbeiter: Beyer
Datum: 4/16/2005
Typ: C2aM16MOA
Wafer: C214
Chip: G10
Schirmung: none
Temperatur: 4.2

Elektronik:

ElekTyp: SEL-PTB001
Reset Gain 4000
Vb range 250 μV
Ib range 62.5 μA
Rfb 30000 Ohm
Rf 30000 Ohm

Funktion: ok, HD

Messung Reset-Mode:

1/MF: 125.000 $\mu\text{A}/\text{phi}0$
1/MFZ: $\mu\text{A}/\text{phi}0$
1/MFFZ: $\mu\text{A}/\text{phi}0$
1/MI: 4.530 $\mu\text{A}/\text{phi}0$
1/MZ: $\mu\text{A}/\text{phi}0$

abgeschätzte parasitäre Flächen:

AParAx: μm^2
AParTrans: μm^2

DVmax: 319.000 μV
Ib(Dvmax): 9.910 μA
RN: Ohm

Messung FLL-Mode:

VbFLL: 136.7 μV
IbFLL: 8.01 μA

VphiFLL: 1443.8 $\mu\text{V}/\text{phi}0$
1/MdynFLL: 21.03 $\mu\text{A}/\text{phi}0$
RdynFLL: 68.654 Ohm

BCF:

BCF via: none
VphiBCF: $\mu\text{V}/\text{phi}0$
1/MdynBCF: $\mu\text{A}/\text{phi}0$
RdynBCF: Ohm

Rauschmessungen:

SphiBemerk.:
SphiVb: 136.7 μV
Sphilb: 8.01 μA

Sphi1000: 0.422 $\mu\text{phi0}/\text{sqrtHz}$ (intrinsic: 0.255)
Sphi100: $\mu\text{phi0}/\text{sqrtHz}$
Sphi10: $\mu\text{phi0}/\text{sqrtHz}$
Sphi1: $\mu\text{phi0}/\text{sqrtHz}$
Sphi0,1: $\mu\text{phi0}/\text{sqrtHz}$

LIR: nH
LIF: nH
LIFZ: nH
LIFZ: nH